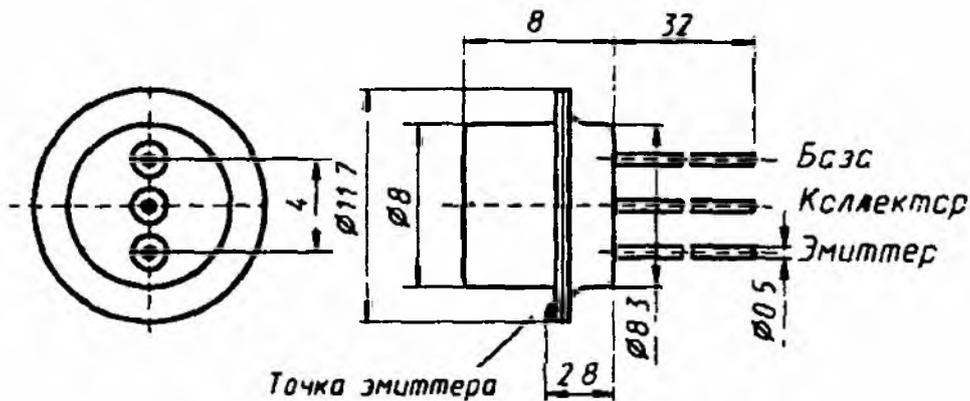


2Т321А, 2Т321Б, 2Т321В, 2Т321Г, 2Т321Д, 2Т321Е, КТ321А, КТ321Б, КТ321В, КТ321Г, КТ321Д, КТ321Е

Транзисторы кремниевые, эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* импульсные. Предназначены для применения в импульсных усилителях и переключающих устройствах. Выпускаются в металlostеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 2,2 г.

Изготовитель — Нальчинский завод полупроводниковых приборов, г. Нальчик.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ:

при $U_{кэ} = 3$ В, $I_k = 50$ мА, $T = +25$ °С:	
2Т321А, 2Т321Г, КТ321А, КТ321Г	20...60
2Т321Б, 2Т321Д, КТ321Б, КТ321Д.....	40...120
2Т321В, 2Т321Е, КТ321В, КТ321Е.....	80...200
при $U_{кэ} = 3$ В, $I_k = 50$ мА, $T = -60$ °С:	
2Т321А, 2Т321Г	10...120
2Т321Б, 2Т321Д.....	20...240
2Т321В, 2Т321Е	40...400
при $U_{кэ} = 3$ В, $I_k = 50$ мА, $T = +125$ °С:	
2Т321А, 2Т321Г	8...120
2Т321Б, 2Т321Д.....	16...240
2Т321В, 2Т321Е	32...400
при $U_{кэ} = 8$ В, $I_k = 1,5$ А, $T = +25$ °С, не менее:	
2Т321А, 2Т321Г	15
2Т321Б, 2Т321В, 2Т321Д, 2Т321Е	20

Граничная частота коэффициента передачи тока при $U_{КБ} = 10$ В, $I_3 = 15$ мА, не менее	60 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КБ} = 10$ В, $I_3 = 15$ мА, $f = 5$ МГц, не более	400 пс
Время рассасывания при $I_к = 700$ мА и $I_б = 70$ мА для 2Т321А, 2Т321Г, КТ321А, КТ321Г, $I_б = 35$ мА для 2Т321Б, 2Т321Д, КТ321Б, КТ321Д, $I_б = 175$ мА для 2Т321В, 2Т321Е, КТ321В, КТ321Е, не более	1 мкс
Граничное напряжение при $I_3 = 0,5$ А, не менее:	
2Т321А, 2Т321Б, 2Т321В	45 В
2Т321Г, 2Т321Д, 2Т321Е	35 В
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_к = 700$ мА, $I_б = 140$ мА для 2Т321А, 2Т321Г, КТ321А, КТ321Г, $I_б = 70$ мА для 2Т321Б, 2Т321Д, КТ321Б, КТ321Д, $I_б = 35$ мА для 2Т321В, 2Т321Е, КТ321В, КТ321Е, не более	2,5 В
Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_к = 700$ мА, $I_б = 140$ мА для 2Т321А, 2Т321Г, КТ321А, КТ321Г, $I_б = 70$ мА для 2Т321Б, 2Т321Д, КТ321Б, КТ321Д, $I_б = 35$ мА для 2Т321В, 2Т321Е, КТ321В, КТ321Е, не более	1,3 В
Обратный ток коллектора, не более:	
при $T = +20$ °С, $U_{КБ} = U_{КБ, \text{МАКС}}$	100 мкА
при $T = +125$ °С, $U_{КБ} = 30$ В для 2Т321А, 2Т321Б, 2Т321В, 2Т321Г, 2Т321Д, 2Т321Е	300 мкА
Обратный ток коллектор—эмиттер при $U_{КЭ} = U_{КЭ, \text{МАКС}}$, $R_{БЭ} \leq 100$ Ом для 2Т321А, 2Т321Б, 2Т321В, 2Т321Г, 2Т321Д, 2Т321Е, не более	200 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 4$ В, не более	100 мкА
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10$ В, не более:	
2Т321А, 2Т321Б, 2Т321В, 2Т321Г, 2Т321Д, 2Т321Е	40 пФ
КТ321А, КТ321Б, КТ321В, КТ321Г, КТ321Д, КТ321Е	80 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0,5$ В, не более	250 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение коллектор—база:	
2Т321А, 2Т321Б, 2Т321В, КТ321А, КТ321Б, КТ321В	60 В
2Т321Г, 2Т321Д, 2Т321Е, КТ321Г, КТ321Д, КТ321Е	45 В
Напряжение коллектор—эмиттер	
при $R_{\text{БЭ}} \leq 1 \text{ кОм}$:	
2Т321А, 2Т321Б, 2Т321В, КТ321А, КТ321Б, КТ321В	50 В
2Т321Г, 2Т321Д, 2Т321Е, КТ321Г, КТ321Д, КТ321Е	40 В
Напряжение эмиттер—база	4 В
Постоянный ток коллектора	200 мА
Постоянный ток базы	30 мА
Импульсный ток коллектора ¹ при $t_{\text{и}} \leq 30 \text{ мкс}$, $Q \geq 300$, $T \leq +45 \text{ }^\circ\text{C}$	2 А
Импульсный ток базы	0,5 А
Постоянная или средняя рассеиваемая мощ- ность коллектора при $T \leq +45 \text{ }^\circ\text{C}$	210 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность коллек- тора ¹ при $t_{\text{и}} \leq 30 \text{ мкс}$, $Q \geq 300$, $T \leq +45 \text{ }^\circ\text{C}$	20 Вт
Тепловое сопротивление переход—среда	0,5 $^\circ\text{C}/\text{мВт}$
Температура p - n перехода	+150 $^\circ\text{C}$
Температура окружающей среды	-60...+125 $^\circ\text{C}$

¹ В диапазоне температур +45...+125 $^\circ\text{C}$ допустимые значения импульсного тока коллектора и импульсной рассеиваемой мощности снижаются линейно на 0,01 А/ $^\circ\text{C}$ и 0,18 Вт/ $^\circ\text{C}$ соответственно.